

Из рис. 2 (а) видно, что наблюдается эффект десенсибилизации в собственной области поглощения галогенида серебра. При высоких экспозициях фотослой с красителем № 3980 (рис. 2 (а), кривая 1) поглощает равномерно от 500 до 700 нм, имея предельно промеряемую оптическую плотность почернения. При низких освещенностях (рис. 2 (а), кривая 2), фотослой имеет наибольшую чувствительности при 600-675 нм. Поглощение в области 600-675 нм соответствует адсорбции красителя в J-состоянии (рис. 1 (а), кривая 4). Совокупность этих факторов - расширение области поглощения более чем 700 нм, при максимальной плотности почернения; адсорбция красителя в J-состоянии (известно, что сенсбилизация красителем, адсорбированным в J-состоянии, протекает наиболее эффективно) на поверхности микрокристаллов - привела к увеличению общей светочувствительности фотослоя (табл. 2) в четыре раза большей, чем спектрально несенсибилизированного фотослоя.

При сопоставлении спектра отражения (рис. 1 (б), кривая 3) и спектральной чувствительности (рис. 2 (б), кривые 1 и 2) для красителя № 4383, вводимого в количестве $1,0 \cdot 10^{-4}$ моль/моль Ag можно заключить, что образование протяженных J - агрегатов на поверхности плоского гетероконтактного микрокристалла усиливает спектральную чувствительность в области от 525 до 575 нм, причем при высоких экспозициях чувствительность к свету с длиной волны 575 нм максимальна во всем исследованном диапазоне длин волн. Для низких освещенностей диапазон максимальной чувствительности смещается немного в коротковолновую область,

к 550 и 525 нм. Наличие же в системе H - состояния красителя, возможно, блокирует центры химической сенсбилизации, адсорбируясь на них, что приводит к рекомбинации дырок красителя с электронами, которые захватываются на центрах чувствительности при поглощении галогенидом в собственной области поглощения. Поэтому, в сравнении с кривыми 1' и 2', соответствующими спектральной чувствительности только химически-сенсбилизированных фотослоев, относительные величины светочувствительности в приведенных единицах оптической плотности (кривые 1 и 2), в собственной области поглощения галогенида серебра значительно ниже, особенно при высоких экспозициях.

Эффект десенсибилизации не проявляется при больших экспозициях при концентрации красителя № 3461 - $1,0 \cdot 10^{-3}$ моль/моль Ag (рис. 2 (в), кривая 1). Краситель № 3461, адсорбированный в молекулярном состоянии (рис. 1 (в)) на поверхности плоских микрокристаллов расширяет область поглощения до 725 нм, причем спектральная чувствительность значительно увеличивается в области 525-650 нм. при низких освещенностях (рис. 2 (в), кривая 2), что соответствует поглощению красителя также в молекулярном состоянии (рис. 1 (в)).

Литература

1. Бреслав, Ю. А. Частное сообщение / Ю. А. Бреслав. - М., 2002.
2. Maskasky, J. E. Epitaxial selective site sensitization of tabular grain emulsion / J. Imag. Sci. - 1988. - V. 32. - № 4. - P. 160-177.

УДК 544.032

Э. П. Суровой, Н. В. Борисова, И. В. Титов

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ ГЕТЕРОСИСТЕМ «МЕДЬ – ОКСИД МЕДИ (I)»

Благодаря комплексу положительных свойств, металлы нашли широкое применение в различных областях науки, техники, промышленности. Они используются в качестве конструкционных материалов [1, 2]. Металлы применяются в интегральной электронике [3]. Тонкие металлические слои, «просветленные» оксидами металлов, применяются для изготовления теплоотражающих покрытий [4]. Создание контактов их со светочувствительными материалами приводит к изменению фоточувствительности последних [5–8]. Однако металлическое состояние для большинства металлов в атмосферных условиях термодинамически неустойчиво [1, 2]. При контактировании с окружающей средой металлы подвергаются атмосферной коррозии [1, 2].

Среди важнейших металлов для современной промышленности особое место занимает медь. Медь относится к группе полублагородных металлов, которые имеют положительное значение свободной энергии при протекании реакции ионизации только

в отсутствие кислорода [1, 2]. Расширение областей применения меди выдвигает новые научно-технические задачи, поднимает требования к свойствам медных изделий [9]. Изучение природы и закономерностей процессов, протекающих при тепловом воздействии, в меди и на ее поверхности представляется необходимым, как для решения группы научных задач, в частности, выяснения степени общности процессов, протекающих на границе между металлом, оксидом и окружающей атмосферой, так и в связи с необходимостью разработки принципиально новых материалов для полупроводниковой микроэлектроники.

В настоящей работе представлены результаты цикла исследований, направленных на выяснение природы и закономерностей процессов, протекающих в условиях атмосферы в тонких слоях меди, в зависимости от толщины материала, температуры и времени теплового воздействия.

Объекты и методы исследования

Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме ($2 \cdot 10^{-3}$ Па) путем нанесения тонких ($3 \div 100$ нм) слоев меди на подложки из стекла, используя вакуумный универсальный пост ВУП-5М. В качестве испарителя использовали лодочки, изготовленные из молибдена толщиной $d=3 \cdot 10^{-4}$ м. Оптимальное расстояние от лодочки-испарителя до подложки составляет $8 \div 9$ см.

Подложками служили стекла от фотопластинок толщиной $1 \cdot 10^{-3}$ м и площадью $2 \cdot 10^{-4} \div 4 \cdot 10^{-4}$ м², которые подвергали предварительной обработке в концентрированной азотной кислоте, в растворе бихромата калия в концентрированной серной кислоте, в кипящей мыльной воде, промывали в дистиллированной воде и сушили [10, 11]. Обработанные подложки оптически прозрачны в диапазоне $300 \div 1100$ нм.

Толщину медных пленок определяли спектрофотометрическим, микроскопическим и гравиметрическими методами [1]. Гравиметрический метод основан на определении приращения массы Δm подложки после нанесения на нее пленки. Среднюю толщину пленки после взвешивания на весах ВЛР-200 с точностью до $5 \cdot 10^{-5}$ г рассчитывали по формуле:

$$d_n = \Delta m / F_n \cdot \rho_m,$$

где Δm – приращение массы подложки после нанесения на нее пленки, F_n – площадь пленки на подложке, ρ_m – удельная масса нанесенного вещества [11].

Образцы подвергали термической обработке в сушильных шкафах Metmert «BE 300» и «SPT-200», в муфельной печи «Тулячка-3П» в интервале температур $373 \div 600$ К. При этом образцы помещали на разогретую до соответствующей температуры фарфоровую пластину и подвергали термической обработке в течение $1 \div 120$ мин. в атмосферных условиях. Регистрацию эффектов после термической обработки исследуемых образцов осуществляли гравиметрическим, микроскопическим и спектрофотометрическим в диапазоне длин волн $300 \div 1100$ нм (используя спектрофотометр «Shimadzu UV-1700») методами.

Результаты и обсуждение

В результате исследований оптических свойств тонких слоев меди, нанесенных на стеклянные подложки до, в процессе и после термической обработки в атмосферных условиях, прежде всего было установлено, что спектры поглощения пленок меди до термообработки существенно зависят от их толщины. На рис. 1 представлены спектры поглощения пленок меди разной толщины в диапазоне ($d=3 \div 100$ нм). Видно, что в исследуемом диапазоне длин волн на спектральных кривых поглощения образцов толщиной более 4 нм можно выделить характерные для меди полосы поглощения (в частности, – минимум оптической плотности при $\lambda=570$ нм) [12]. По мере уменьшения толщины медных пленок, на спектрах поглощения постепенно перестают проявляться характерные для меди полосы поглощения. Для пленок меди толщиной ($d < 4$ нм)

наблюдается бесструктурное поглощение в диапазоне $\lambda = 300 \div 1100$ нм.

В результате термической обработки пленок меди в интервале температур ($T = 373 \div 600$ К) в атмосферных условиях, спектры поглощения, толщина и вес образцов претерпевают существенные изменения. Причем, наблюдаемые изменения спектров поглощения, толщины и веса после термической обработки образцов в значительной степени зависят от первоначальной толщины медных пленок, температуры и времени термообработки.

На рис. 2, в качестве примера приведены спектры поглощения пленок меди толщиной $d=16$ нм до и после термической обработки при 373 К. Видно, что термическая обработка приводит к существенным изменениям вида спектральных кривых поглощения образцов.

Отметим, что наблюдаемые изменения не аддитивны в рассматриваемом спектральном диапазоне длин волн. Наряду с уменьшением в интервале $\lambda=420 \div 1100$ нм и увеличением в интервале $\lambda=300 \div 420$ нм оптической плотности образца формируется спектр поглощения нового вещества. Оцененная по длинноволновому порогу поглощения, который находится при $\lambda=560 \div 570$ нм, оптическая ширина запрещенной зоны образующегося вещества составляет $E=2,17 \div 2,21$ эВ. Полученное значение ширины запрещенной зоны вещества удовлетворительно совпадает с шириной запрещенной зоны оксида меди (I) ($E=2,18$ эВ) [13, 14]. Поэтому было сделано предположение, что при термической обработке пленок меди основным продуктом взаимодействия их с ингредиентами окружающей среды является оксид меди (I).

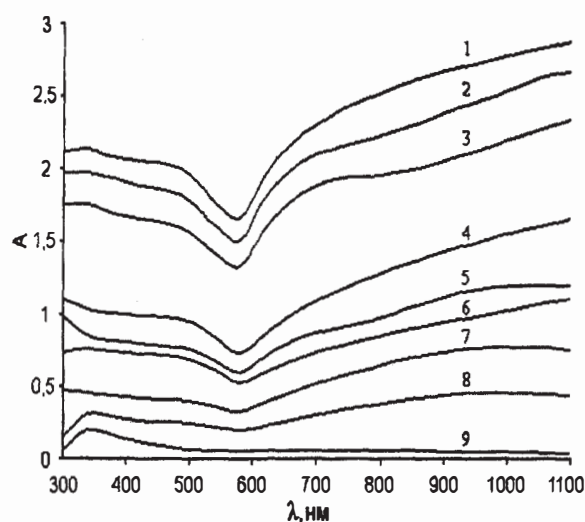


Рис. 1. Спектры поглощения (A) пленок меди толщиной: 1) 112, 2) 100, 3) 88, 4) 62, 5) 47, 6) 40, 7) 31, 8) 18, 9) 3 нм

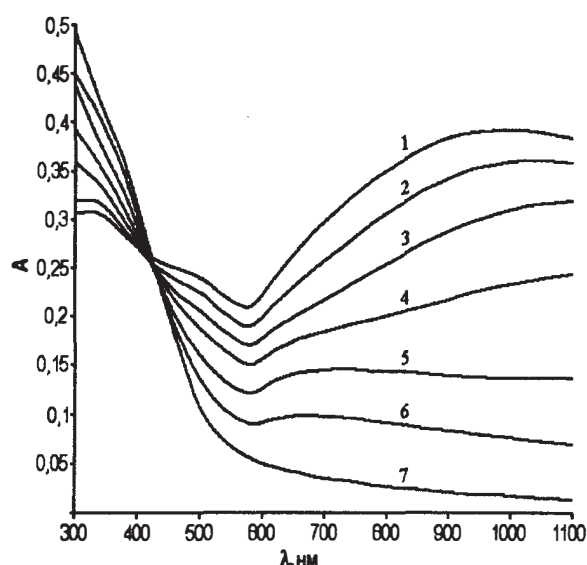


Рис. 2. Спектры поглощения (A) пленки меди толщиной 16 нм до и после предварительной термической обработки при 373 К: 1) без термообработки, 2) 2, 3) 5, 4) 10, 5) 20, 6) 30, 7) 60 мин.

Спектры поглощения пленок меди, измеренные при различных временах термической обработки, пересекаются в одной (изобестической) точке при $\lambda = 420$ нм, в которой оптическая плотность не зависит от времени термообработки, а интенсивность поглощения слоями меди и оксида меди (I) одинакова. Слева и справа от изобестической точки поглощение (A) зависит от времени термической обработки, а при определенном времени термической обработки будет складываться из поглощения,

связанного с наличием слоя меди (A_{Cu}) и оксида

меди (I) (A_{Cu_2O}): $A = A_{Cu} + A_{Cu_2O}$

Если обозначить через α степень термического превращения пленок меди в оксид меди (I), то, при длине волны (например, $\lambda = 900$ нм – рис. 2), соответствующей спектральной области, в пределах которой медь поглощает, а оксид меди (I) практически не поглощает свет [12], текущие оптические

плотности пленок меди (A_{Cu}) и оксида меди (I)

(A_{Cu_2O}) можно представить в следующем виде:

$$A_{Cu} = A_{Cu}^1 (1 - \alpha),$$

$$A_{Cu_2O} = A_{Cu_2O}^1 \alpha,$$

где A_{Cu}^1 , $A_{Cu_2O}^1$ – предельная оптическая плотность слоя меди и оксида меди (I) при $\lambda = 900$ нм.

В итоге получаем следующее выражение для степени термического превращения пленки меди в оксид меди (I):

$$A = A_{Cu}^1 (1 - \alpha) + A_{Cu_2O}^1 \alpha,$$

$$\alpha = (A_{Cu}^1 - A) / (A_{Cu}^1 - A_{Cu_2O}^1).$$

Закономерности изменения спектров поглощения пленок меди по мере увеличения температуры термической обработки сохраняются (в коротковолновой области спектра – слева от изобестической точки, наблюдается увеличение оптической плотности, в длинноволновой области спектра – справа от изобестической точки, наблюдается уменьшение оптической плотности образцов). С увеличением температуры, при которой осуществлялась термическая обработка пленок меди одинаковой исходной толщины, имеет место увеличение эффектов изменения оптической плотности. По мере увеличения толщины, слоя меди (вплоть до 100 нм) при постоянной температуре (в интервале 373–600 К) термической обработки, наблюдается последовательное уменьшение эффектов изменения оптической плотности образцов во всем исследованном спектральном диапазоне. Термическая обработка пленок меди толщиной $d < 16$ нм в течение $\tau < 1$ мин приводит к резкому увеличению в коротковолновой (слева от изобестической точки) и к уменьшению в длинноволновой областях спектра (справа от изобестической точки) оптической плотности. При дальнейшем увеличении времени термической обработки образцов заметных изменений оптической плотности в разных спектральных областях не обнаружено.

Для выяснения закономерностей протекания процесса взаимодействия пленок меди с активными ингредиентами окружающей среды (используя результаты измерений спектров поглощения пленок меди разной толщины до и после термической обработки образцов при разных температурах) были рассчитаны и построены кинетические зависимости степени превращения $\alpha = f(\tau)$ при различных длинах волн.

В результате обработки спектров поглощения было установлено, что степень термического превращения пленок меди зависит от первоначальной толщины, температуры и времени термической обработки. Для пленок меди толщиной ($d_n < 16$ нм) в изученном интервале температур степень превращения достигает единицы за $\tau = 1 \div 5$ мин. Кинетические зависимости степени превращения в результате термической обработки пленок меди толщиной: $d_n < 4$ нм (при 373 и 423 К), $d_n < 50$ нм (473 К), $d_n < 60$ нм (523 К), $d_n < 140$ нм (300 К), вплоть до обеспечения полного окисления пленок меди до оксида меди (I), практически линейны. При увеличении температуры термообработки угол наклона прямой в координатах $\alpha = f(\tau)$ возрастает. По мере увеличения толщины пленок меди, температуры и времени термической обработки, кинетические кривые степени превращения удовлетворительно описываются в рамках параболического или логарифмического законов. На рис. 3, в качестве примера, приведены кинетические кривые степени превращения пленок меди при 473 К в зависимости от первоначальной толщины образцов.

Видно, что по мере увеличения толщины пленок меди наблюдается увеличение времени достижения степени превращения равной единице. На рис. 4 представлены кинетические зависимости изменения массы пленок меди за счет образования оксида меди (I) в процессе термической обработки при 423 К. Видно, что в процессе термической обработки наблюдается увеличение массы образца. Причем интенсивность процесса окисления при постоянной температуре термической обработки тем больше, чем меньше первоначальная толщина пленок меди. По мере уменьшения первоначальной толщины пленок меди, всё более ярко проявляется точка перегиба. При более высоких температурах процесс окисления протекает в наибольшей степени, что особенно заметно на начальных участках. С увеличением температуры термической обработки увеличивается массовая доля образовавшегося оксида меди (I).

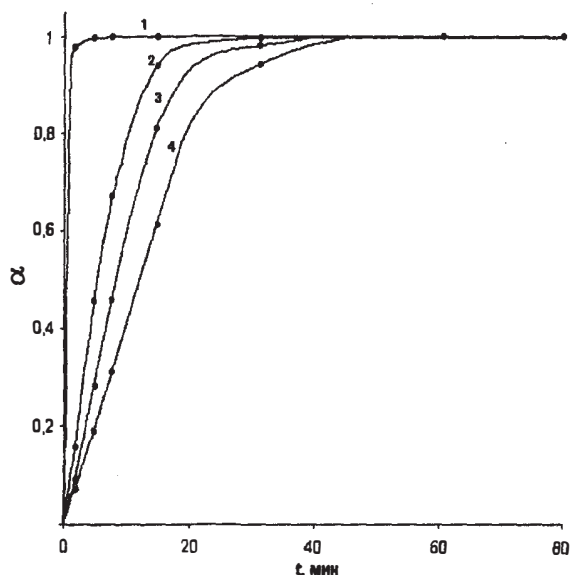


Рис. 3. Зависимость степени превращения от толщины пленок меди при 473 К:
1) 4, 2) 37, 3) 41, 4) 47 нм

При сопоставлении масс оксида меди (I), определенных по кинетическим кривым при разных температурах термической обработки в условиях полного окисления пленок меди разной толщины и рассчитанных по уравнению реакции окисления $2\text{Cu} + 0,5\text{O}_2 = \text{Cu}_2\text{O}$, установлено их удовлетворительное совпадение. Этот факт также является дополнительным свидетельством того, что в процессе термической обработки пленок меди образуется слой оксида меди (I).

В процессе термической обработки наблюдается и увеличение толщины пленок меди. На рис. 5 представлены кинетические кривые изменения толщины, образующегося на поверхности пленок меди различной начальной толщины оксида меди (I) при 373 К. Видно, что толщина оксида меди (I) в процессе термической обработки пленок меди увеличивается. При термической обработке пленок меди

различной толщины при более высоких температурах установлено, что значительный и достаточно резкий прирост толщины оксида меди (I) наблюдается уже при небольших временах термообработки. Причем скорость прироста оксида меди (I) тем больше, чем меньше толщина пленки меди.

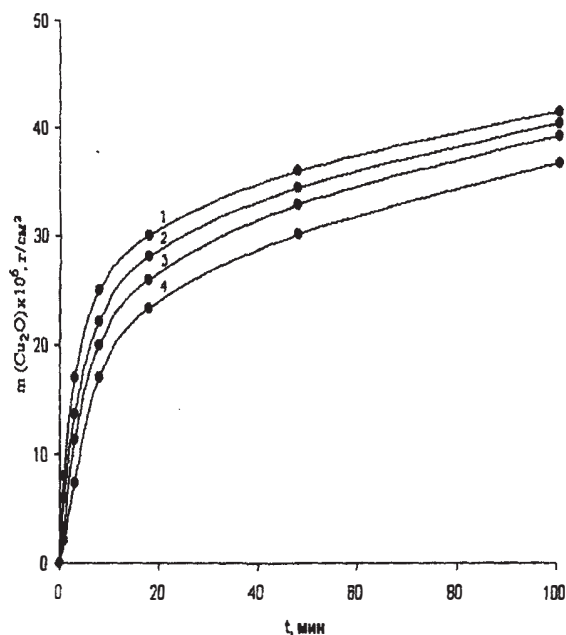


Рис. 4. Зависимость массы оксида меди (I) от времени термической обработки (423 К):
1) 43, 2) 63, 3) 64, 4) 100 нм

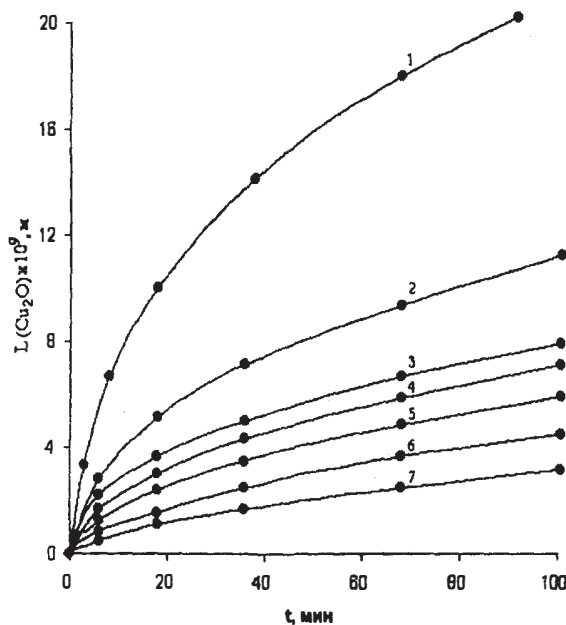


Рис. 5. Зависимость толщины оксида меди (I) от времени термической обработки (373 К):
1) 16, 2) 31, 3) 40, 4) 44, 5) 50, 6) 62, 7) 88 нм

Отличие характеров кинетических закономерностей, представленных на рис. 3 и рис. 4, можно объяснить тем фактом, что при расчетах по спектрам оптического поглощения степеней пре-

вращения (α) не были учтены процессы отражения света от поверхности исследуемых образцов.

Известно [1, 2], что одним из основных условий, характеризующих способность образованного первичного слоя продуктов взаимодействия ингредиентов окружающей среды с металлом, – тормозить дальнейшее окисление металла, является сплошность получаемой окисной пленки. Образующаяся окисная пленка будет препятствовать проникновению агентов, участвующих в процессе окисления, и таким образом тормозить дальнейший ее рост. Согласно критерию Пиллинга и Бедвортса, который для меди составляет 1,64 [1], следовало ожидать образования сплошной окисной пленки, значительно тормозящей дальнейшее протекание процесса окисления и, как следствие, в идеальном случае – параболического закона процесса окисления пленок меди, лимитируемого диффузией ионов меди через слой окисла к его поверхности [1, 2]:

$$L^2 = K\tau + A,$$

где L – толщина пленки, τ – время окисления, K – константа скорости окисления, A – постоянная интегрирования.

В результате исследований установлено, что скорость роста окисной пленки на поверхности пленок меди толщиной $d_n < 4$ мкм (термическая обработка при 373 и 423 К), $d_n < 50$ нм (температура термической обработки 473 К), толщиной $d_n < 6 \cdot 10^{-8}$ м (523 К) и толщиной $d_n < 140$ мкм (температура термообработки 300 К) (вплоть до обеспечения полного окисления пленок меди) остается практически постоянной – как это имеет место для щелочных и щелочноземельных металлов, для которых критерий Пиллинга и Бедвортса менее единицы [1]:

$$DL / d\tau = K,$$

или после интегрирования

$$L = K\tau + A.$$

Таким образом, толщина окисной пленки, образующейся на поверхности пленок меди (установленных размеров и подвергаемых термической обработке при соответствующих температурах), будет пропорциональна времени окисления. Отсюда следует, что критерий $V_{ок}/V_{ме} > 1$ (где $V_{ок}$ – объем окисла, $V_{ме}$ – объем металла) [1] не выполняется, окисная пленка, по-видимому, имеет рыхлую структуру со слабыми защитными свойствами и лимитирующей стадией процесса окисления, вероятно, является непосредственно сама химическая реакция взаимодействия меди с кислородом окружающей среды.

По мере увеличения толщины пленок меди в результате термической обработки при разных температурах, кинетические кривые их окисления удовлетворительно описываются в рамках параболического или логарифмического законов. Таким образом, для пленок меди толщиной $d_n > 50$ мкм в результате химической коррозии будут формироваться сплошные окисные пленки, и процесс коррозии будет тормозиться диффузией ионов меди через окисную пленку (лимитирующей стадией процесса коррозии является диффузия ионов меди к границе

поверхности оксидного слоя с окружающей средой), дальнейший рост которой будет замедляться при увеличении толщины окисной пленки [1, 2].

Работа поддержана грантом Президента РФ для поддержки ведущих научных школ НШ – 20.2003.3.

Литература

1. Томашов, Н. Д. Теория коррозии и защиты металлов / Н. Д. Томашов. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 592 с.
2. Бахвалов, Г. Т. Защита металлов от коррозии / Г. Т. Бахвалов. – М.: Металлургия, 1964. – 288 с.
3. Стриха, В. И. Физические основы надежности контактов металл-полупроводник в интегральной электронике / В. И. Стриха, Е. В. Бузанева. – М.: Радио и связь, 1987. – 254 с.
4. Спиридонов, А. В. Современное состояние и перспективы совершенствования светопрозрачных ограждений / А. В. Спиридонов // Строительные материалы. – 1998. – № 7. – С. 4–6.
5. Индутный, И. З. Фотостимулированные взаимодействия в структурах металл – полупроводник / И. З. Индутный, М. Т. Костышин, О. П. Касярум, В. И. Минько, Е. В. Михайловская, П. Ф. Романенко. – Киев: Наукова думка, 1992. – 240 с.
6. Суровой, Э. П. Фотолиз гетеросистем $AgN_3(A)$ – металл / Э. П. Суровой, С. М. Сирик, Л. Н. Бугерко // Химическая физика. – 2000. – Т. 19. – № 8. – С. 22–25.
7. Суровой, Э. П. Фотолиз гетеросистем азид таллия – металл / Э. П. Суровой, Л. И. Шурыгина, Л. Н. Бугерко // Химическая физика. – 2001. – Т. 20. – № 12. – С. 15–22.
8. Суровой, Э. П. Фотолиз гетеросистем «азид свинца – кадмий» / Э. П. Суровой, Л. Н. Бугерко, С. В. Расматова // Известия Томского политехнического университета. – 2004. – Т. 307, № 2. – С. 95–99.
9. Бескислородная медь / под ред. А. А. Преснякова. – Алма-Ата: Наука, 1985. – 136 с.
10. Технология тонких пленок / под ред. Л. Майсела, Р. Гленга. – М.: Советское радио, 1977. – Т. 1. – 664 с.
11. Минайчев, В. Е. Нанесение пленок в вакууме / В. Е. Минайчев. – М.: Высшая школа, 1989. – 110 с.
12. Лазарев, В. Б. Химические и физические свойства простых оксидов металлов / В. Б. Лазарев, В. В. Соболев, И. С. Шашлыгин. – М.: Наука, 1983. – 239 с.
13. Вертопрахов, В. Н. Термостимулированные токи в неорганических веществах / В. Н. Вертопрахов, Е. Г. Сальман. – Новосибирск: Наука, 1979. – 336 с.
14. Бьюб, Р. Фотопроводимость твердых тел / Р. Бьюб. – М.: Иностран. лит., 1962. – 559 с.